

サーマルCVD装置 CT-6000



炭化ケイ素(SiC)に代表される超高温材料は、その生成温度と濃度によって様々な結晶構造をとります。サーマルCVD装置CT-6000はこれらの未来材料の研究をするために、制御圧力範囲を6.65～101kPa、制御温度範囲を800～2000℃と幅広く条件を取れるようになっています。

サーマルCVD装置 CT-6000 仕様

○膜種	SiC/C
○炉体サイズ	φ168mm×210mm
○炉体材質	カーボン
○基板形状	自在
○到達圧力	×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻¹ Pa台迄5分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	2000℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiCl ₄ /C ₃ H ₈ /H ₂ /N ₂
○真空排気系	油回転ポンプ:1200L/min メカニカルブースターポンプ:300m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気:AC200V三相60kVA 冷却水:60L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上